



BD 644 · BD 646 · BD 648 · BD 650

Silizium-PNP-Darlington-Leistungstransistoren Silicon PNP Darlington Power Transistors

Anwendungen: NF-Endstufen

Applications: AF-Output stages

Besondere Merkmale:

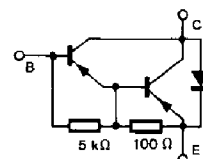
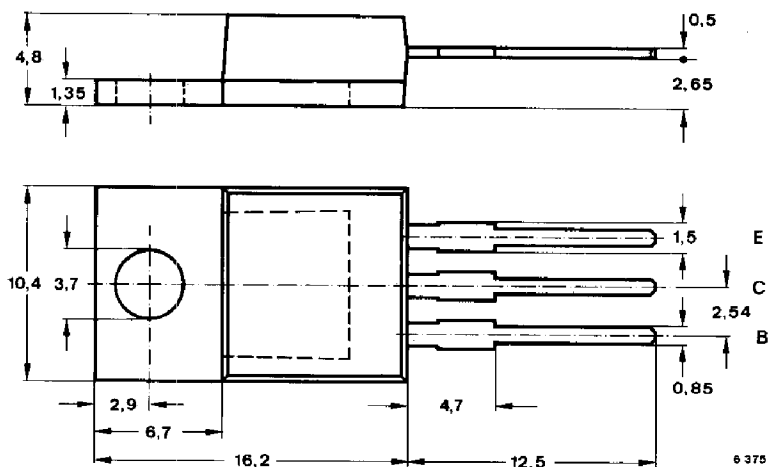
- Hohe Sperrspannung
- Sehr hohe Stromverstärkung
- Verlustleistung 62,5 W
- Glaspassivierung
- BD 644, BD 646, BD 648, BD 650 sind komplementär zu BD 643, BD 645, BD 647, BD 649

Features:

- High reverse voltage
- Very high current transfer ratio
- Power dissipation 62.5 W
- Glass passivation
- BD 644, BD 646, BD 648, BD 650 are complementary to BD 643, BD 645, BD 647, BD 649

Vorläufige technische Daten · Preliminary specifications

Abmessungen in mm Dimensions in mm



Zubehör Accessories

Isolierscheibe Best. Nr. 564 542
Isolating washer

Isolierbuchse Best. Nr. 513 242
Isolating bush

Kollektor mit
Montagefläche verbunden
Collector connected
with metallic surface

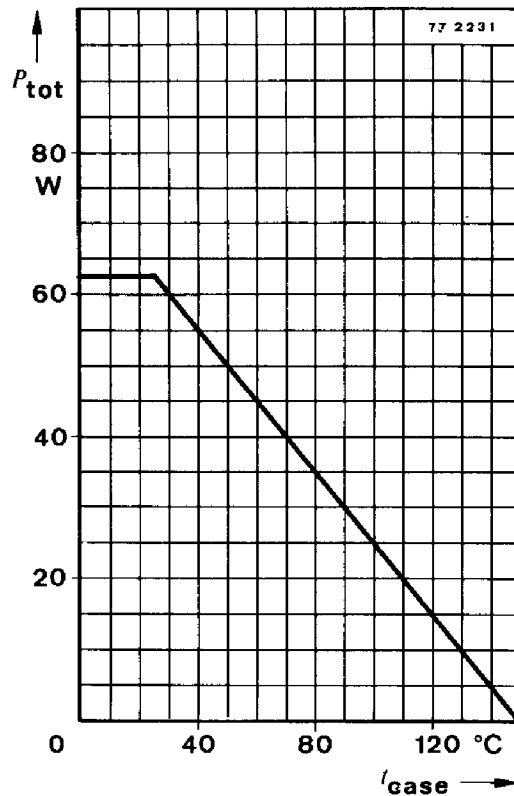
Normgehäuse
Case
14 A 3 DIN 41869
JEDEC TO 220
Gewicht · Weight
max. 1,5 g

BD 644 · BD 646 · BD 648 · BD 650

Absolute Grenzdaten

Absolute maximum ratings

		BD 644	BD 646	BD 648	BD 650	
Kollektor-Basis-Sperrspannung <i>Collector-base voltage</i>	$-U_{CBO}$	45	60	80	100	V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung <i>Collector-emitter voltage</i>	$-U_{CEO}$	45	60	80	100	V
Emitter-Basis-Sperrspannung <i>Emitter-base voltage</i>	$-U_{EBO}$			5		V
Kollektorstrom <i>Collector current</i>	$-I_C$			8		mA
Kollektorspitzenstrom <i>Collector peak current</i>	$-I_{CM}$			12		mA
Basisstrom <i>Base current</i>	$-I_B$			150		mA
Gesamtverlustleistung <i>Total power dissipation</i> $t_{case} \leq 25^\circ\text{C}$	P_{tot}			62,5		mW
Sperrschichttemperatur <i>Junction temperature</i>	t_j			150		$^\circ\text{C}$
Lagerungstemperaturbereich <i>Storage temperature range</i>	t_{stg}			-55 ... +150		$^\circ\text{C}$



BD 644 · BD 646 · BD 648 · BD 650

		Min.	Typ.	Max.
Durchlaßspannung der Schutzdiode <i>Forward voltage of the protection diode</i> $-I_F = 3 \text{ A}$	$-U_F$		1,2	V
Kollektor-Basis-Gleichstromverhältnis <i>DC forward current transfer ratio</i> $-U_{CE} = 3 \text{ V}, -I_C = 4 \text{ A}$	BD 644 h_{FE}	750		
$-I_C = 3 \text{ A}$	BD 646, BD 648, BD 650 h_{FE}	750		
h_{fe} -Grenzfrequenz <i>h_{fe}-cutt-off frequency</i> $-U_{CE} = 3 \text{ V}, -I_C = 4 \text{ A}$	BD 644 f_{hfe}		100	kHz
$-I_C = 3 \text{ A}$	BD 646, BD 648, BD 650 f_{hfe}		100	kHz
Transitfrequenz <i>Gain bandwidth product</i> $-U_{CB} = 3 \text{ V}, -I_C = 3 \text{ A}, f = 1 \text{ MHz}$	f_T		7	MHz